

		Полевые транзисторы / Field effect transistors					
		Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a>					
		On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a>				Цена за 1 шт. в USD	
36	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт
1	24532	2SA1493 -SANKEN	Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor MT-200, -200V, -15 A	-20...+55	10,0000	9,0000	по запросу
2	25451	2SB600 -NEC	Silicon PNP Power Transistor TO-3 -200V -10A (2SB555)	-20...+55	4,5000		по запросу
3	24533	2SC3857 -SANKEN	Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor MT-200, -200V, -15 A	-20...+55	9,0000	8,1000	по запросу
4	25455	2SD555 -NEC	Silicon NPN Power Transistor TO-3 200V 10A (2SB600)	-20...+55	4,5000		по запросу
5	19839	2SK170 -Toshiba	Транз. Пол. N-Channel MOS TO-92 40V, 0,01A 0,4W Low noise	(-55...+150)°C	0,7500	0,7000	по запросу
6	25091	2SK932-24-TB-E -ONS	Транз. Пол. N-Channel JFET SOT-23-3 15 V 0,05A 0,2W	(-55...+150)°C	0,7500	0,7000	по запросу
7	73 1	BUK107-50DL -Philips	Транз. Пол. 6M N-MOSFET SOT223 Udss=50V; Id=0,7A; Pdmaх=1,8W; Rds=0,2 Ohm	(-55...+150)°C	0,8688	0,7688	по запросу
8	73 38	BUK7675-55 -Philips	Транз. Пол. 6M N-MOSFET D2-PAK Udss=55V; Id=19,7A; Pdmaх=61W; Rds=0,075 Ohm	(-55...+175)°C	0,3785	0,3349	по запросу
9	24961	FQPF8N60CFT -Fairchild	MOSFET N-CH 600V 6.26A TO-220F	-20...+55	2,9731	2,8244	по запросу
10	73 48	IPS0551T -IR	Транз. Пол. 6M N-MOSFET FULLY PROTECTED POWER SWITCH SuperTO220 Udss=40V; Id=100A; Rds=0,0052 Ohm; t=4mks	(-40...+150)°C	6,5970	5,8380	по запросу
11	18802	IPS511G -IR	ИМС SOIC8 FULLY PROTECTED HIGH SIDE POWER MOSFET SWITCH	(-40...+150)°C	3,1000	2,7500	по запросу
12	18358	IRF2807SPBF -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET D2PAK Udss=75V; Id=82A; Pdmaх=330W; Rds=0,0013 Ohm	(-55...+175)°C	1,6500	1,5000	по запросу
13	73 32	IRF3205 -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=55V; Id=110A; Pdmaх=200W; Rds=0,008 Ohm	(-55...+175)°C	1,2266	1,0854	по запросу
14	14750	IRF3205SPBF -Infineon Technologies	Транз. Пол. 6M N-HEXFET D2-Pak Udss=55V; Id=110A; Pdmaх=200W; Rds=0,008 Ohm	(-55...+175)°C	1,1000	0,9600	по запросу
15	73 62	IRF3710 -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=100V; Id=57A; Pdmaх=200W; Rds=0,025 Ohm	(-55...+175)°C	1,6914	1,4968	по запросу
16	9417	IRF3808S -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET D2PAK Udss=75V; Id=140A; Pdmaх=330W; Rds=0,007 Ohm	(-55...+175)°C	3,2364	2,8640	по запросу
17	73 3	IRF4905 -IR	Транз. Пол. 6M P-HEXFET TO220AB Udss=-55V; Id=-74A; Pdmaх=150W; Rds=0,02 Ohm	(-55...+175)°C	1,8616	1,6474	по запросу
18	4320	IRF4905S -IR	Транз. Пол. 6M P-HEXFET D2PAK Udss=-55V; Id=-74A; Pdmaх=3,8W; Rds=0,02 Ohm	(-55...+175)°C	2,1265	1,8818	по запросу
19	10847	IRF520NPBF -IR	Транз. Пол. N-канал, TO-220, 9.7 A, 100 В, 48 Вт	(-55...+150)°C	0,6119	0,5415	по запросу
20	7236	IRF5305PBF -IR	Транз. Пол. 6M P-HEXFET TO220AB Udss=-55V; Id=-31A; Pdmaх=110W; Rds=0,06 Ohm	(-55...+175)°C	0,9961	0,8815	по запросу
21	4203	IRF5305SPBF -IR	Транз. Пол. 6M P-HEXFET D2PAK Udss=-55V; Id=-31A; Pdmaх=110W; Rds=0,06 Ohm	(-55...+175)°C	0,9500	0,8300	по запросу
22	10848	IRF530NPBF -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO-220AB Udss=100V; Id=17A; Pdmaх=70W; Rds=90mOhm	(-55...+150)°C	0,6649	0,5884	по запросу
23	23234	IRF530PBF -Vishay	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO-220AB Udss=100V; Id=17A; Pdmaх=70W; Rds=90mOhm	(-55...+150)°C	0,6000	0,5200	по запросу
24	73 58	IRF540N -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=100V; Id=33A; Pdmaх=140W; Rds=0,052 Ohm	(-55...+175)°C	0,8378	0,7414	по запросу
25	24047	IRF5803PBF - IRF		-20...+55			по запросу
26	16787	IRF5805PBF -IR	Транз. Пол. 6M TSOP-6 Id=-3,8A Udss=-30V Pd=2W Rds=0,098 Ohm	(-55...+150)°C	1,0601	0,9381	по запросу
27	17605	IRF5850PBF -IR	Транз. Пол. 6M TSOP6 Id=-2,2A Udss=-20V Pd=0,96W Rds=0,135Ohm	(-55...+150)°C	0,4055	0,3588	по запросу
28	6052	IRF630 -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=200V; Id=9,5A; Pdmaх=50W; Rds=0,3 Ohm	(-55...+150)°C	0,8055	0,7128	по запросу
29	73 22	IRF640 -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=200V; Id=18A; Pdmaх=125W; Rds=0,18 Ohm	(-55...+150)°C	0,7160	0,6336	по запросу
30	10482	IRF640NPBF -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=200V; Id=18A; Pdmaх=125W; Rds=0,18 Ohm (аналог IRF640 только без свинца)	(-55...+175)°C	0,6993	0,6188	по запросу
31	3839	IRF730A -IR	Транз. Пол. 6M N-HEXFET TO220AB Udss=400V; Id=5,5A; Pdmaх=74W; Rds=1 Ohm	(-55...+150)°C	0,7169	0,6344	по запросу
32	8364	IRF740 -IR	Транз. Пол. 6M N-MOSFET TO220AB Udss=400V; Id=10A; Pdmaх=125W; Rds=0,55 Ohm	(-55...+150)°C	1,1019	0,9751	по запросу

				<a href="http://www.store.aly.ru">On-line магазин: www.store.aly.ru</a>		Цена за 1 шт. в USD	
36	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт
33	11209	IRF740SPBF -IR	Транз. Пол. БМ N-MOSFET D2-Pak Udss=400V; Id=10A; Pdmax=125W; Rds=0,55 Ohm	(-55...+150)°C	1,7832	1,5780	по запросу
34	73 59	IRF840APBF -Vishay	Транз. Пол. БМ N-HEXFET TO220AB Udss=500V; Id=8A; Pdmax=125W; Rds=0,85 Ohm	(-55...+150)°C	1,0500	0,9400	по запросу
35	19251	IRF9520PBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET TO220AB Udss=-100V; Id=-6,8A; Rds=0,48 Ohm	(-55...+175)°C	0,8676	0,7680	по запросу
36	73 12	IRF9530NPBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET TO220AB Udss=-100V; Id=-14A; Pdmax=79W; Rds=0,2 Ohm	(-55...+175)°C	0,8680	0,7681	по запросу
37	20822	IRF9530STRLPBF -Vishay	Транз. Пол. БМ P-MOSFET D2PAK Udss=-100V; Id=-12 A; Rds=0,3 Ohm	(-55...+175)°C	1,2000	1,0500	по запросу
38	17753	IRF9540NPBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET TO220AB Udss=-100V; Id=-23A; Pdmax=140W;	(-55...+175)°C	0,8680	0,7681	по запросу
39	19138	IRF9540NSPBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET D2Pak Udss=-100V; Id=-23A; Pdmax=110W;	(-55...+175)°C	0,8676	0,7680	по запросу
40	6280	IRF9630S -IR	Силовой МОП-транзистор P-канальный Vси = -100 В, Rоткр = 0.8 Ом, Id(25oC) = -6.5 А Корпус D2-Pak	(-55...+175)°C	0,7117		по запросу
41	73 55	IRF9640PBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET TO220AB Udss=-200V; Id=-11A; Pdmax=125W; Rds=0,5 Ohm	(-55...+150)°C	1,3887	1,2289	по запросу
42	10456	IRF9Z24NPBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET TO220AB Udss=-55V; Id=-12A; Pdmax=45W; Rds=0,175 Ohm (аналог IRF9Z24N только Pb free)	(-55...+175)°C	0,6046	0,5350	по запросу
43	10457	IRF9Z34NPBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET TO220AB Udss=-55V; Id=-17A; Pdmax=56W; Rds=0,10 Ohm (аналог IRF9Z34N только Pb free)	(-55...+175)°C	0,7409	0,6556	по запросу
44	13497	IRF9Z34NSPBF -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET D2Pack Udss=-55V; Id=-19A; Pdmax=68W; Rds=0,10 Ohm (Pb free)	(-55...+175)°C	0,7409	0,6556	по запросу
45	25620	IRFB260NPBF -Infineon	N-MOSFET; unipolar; HEXFET; 200V; 56A; 380W; TO220AB	-20...+55	2,2000	2,0000	по запросу
46	20708	IRFBE30 - VISH/IR	Транзистор пол. N-MOSFET TO-220-3	-20...+55			по запросу
47	9801	IRFP064NPBF -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET TO247AC Udss=60V; Id=70A; Pdmax=300W; Rds=0,009 Ohm	(-55...+150)°C	2,0134	1,7062	по запросу
48	10754	IRFP360LC -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET TO247AC Udss=400V; Id=23A; Pdmax=280W; Rds=0,2 Ohm	(-55...+150)°C	5,2429	4,6397	по запросу
49	16458	IRFP4004PBF -IR	Транз. Пол. БМ N-MOSFET TO247 Udss=40V; Id=195A; Rds=0,0017 Ohm; RoHS	(-55...+150)°C	6,4182	5,6798	по запросу
50	16459	IRFP4468PBF -IR	Транз. Пол. БМ N-MOSFET TO247 Udss=100V; Id=195A; Rds=0,0026 Ohm; RoHS	(-55...+150)°C	9,0549	8,0131	по запросу
51	73 24	IRFP460A -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET TO247AC Udss=500V; Id=20A; Pdmax=280W; Rds=0,27 Ohm	(-55...+150)°C	6,1105	5,4075	по запросу
52	73 14	IRFR024N -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET D-PAK Udss=55V; Id=17A; Pdmax=45W; Rds=0,075 Ohm	(-55...+175)°C	0,5013	0,4436	по запросу
53	17355	IRFR110PBF -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET D-PAK Udss=100V; Id=4,3A; Rds=0,54 Ohm	(-55...+175)°C	1,1043	0,9772	по запросу
54	73 30	IRFR120NPBF -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET D-PAK Udss=100V; Id=9,4A; Pdmax=48W; Rds=0,21 Ohm	(-55...+175)°C	0,7222	0,6391	по запросу
55	11211	IRFR310PBF -IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET D-PAK Udss=400V; Id=1,7 A; Pdmax=42W; Rds=3,6 Ohm	(-55...+150)°C	1,0916	0,9660	по запросу
56	73 5	IRFR320TRPBF -Vishay/IR	Транз. Пол. БМ N-HEXFET D-PAK Udss=400V; Id=3,1A; Pdmax=42W; Rds=1,8 Ohm	(-55...+150)°C	0,9200	0,8000	по запросу
57	22202	IRFR3411PBF -IR	Транз. Пол. БМ N-MOSFET DPAK Udss=100V; Id=32 A; Pdmax=130 W; Rds=0,044 Ohm	(-55...+150)°C	1,0920	0,9660	по запросу
58	22203	IRFR3910PBF -IR	Транз. Пол. БМ N-MOSFET DPAK Udss=100V; Id=16 A; Pdmax=79 W; Rds=0,115 Ohm	(-55...+150)°C	1,0920	0,9660	по запросу
59	17596	IRFR9014PBF -Vishay	Транз. Пол. БМ P-HEXFET D-PAK Udss=-60V; Id=-20 A; Pdmax=25 W; Rds=0,5 Ohm	(-55...+150)°C	0,7700	0,7000	по запросу
60	73 33	IRFR9024N -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET D-PAK Udss=-55V; Id=-11A; Pdmax=38W; Rds=0,175 Ohm	(-55...+150)°C	0,4963	0,4392	по запросу
61	73 53	IRFR9120N -IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET D-PAK Udss=-100V; Id=-6,6A; Pdmax=40W; Rds=0,48 Ohm	(-55...+150)°C	0,6289	0,5565	по запросу
62	5413	IRFR9220 - IR	Транз. Пол. БМ P-HEXFET D-PAK Udss=-200V; Id=-3,6A; Pdmax=42W; Rds=1,5 Ohm	(-55...+150)°C	0,6927	0,6130	по запросу
63	18568	IRFRC20 - IR	Транзистор полевой БМ D-Pak Udss=600V; Id=2A; Pdmax=42W; Rds=4,4 Ohm	-20...+55			по запросу

				<a href="http://www.store.aly.ru">On-line магазин: www.store.aly.ru</a>		Цена за 1 шт. в USD		
36	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт	
64	7790	IRFS31N20D -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET D2Pak Udss=200V; Id=31A; Pdmax=200W; Rds=0,082 Ohm	(-55...+175)°C	4,4666	3,9527	по запросу	
65	23978	IRFS3607PBF -IR	Транз. Пол. 5M N-MOSFET D2PAK Udss=75V; Id=80 A; Pdmax=140 W; Rds=0,09 Ohm	(-55...+150)°C	1,0920	0,9660	по запросу	
66	22204	IRFS4610PBF -IR	Транз. Пол. 5M N-MOSFET D2PAK Udss=100V; Id=72 A; Pdmax=190 W; Rds=0,014 Ohm	(-55...+150)°C	1,0920	0,9660	по запросу	
67	24665	IRFS7434-7PPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-MOSFET D2PAK-7 Udss=40V; Id=240 A; Pdmax=245 W; Rds=1 mOhm @ 100A, 10V	(-55...+150)°C	4,5000	4,0500	по запросу	
68	73 7	IRFU014 -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET I-PAK Udss=60V; Id=7,7A; Pdmax=25W; Rds=0,2 Ohm	(-55...+150)°C	0,5576	0,4934	по запросу	
69	17120	IRFZ24NPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET TO-220AB Udss=55V; Id=17A; Pdmax=45W; Rds=0,07 Ohm	(-55...+175)°C	0,4828	0,4272	по запросу	
70	7685	IRFZ34N -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET TO-220AB Udss=60V; Id=30A; Pdmax=88W; Rds=0,05 Ohm	(-55...+175)°C	0,6404	0,5667	по запросу	
71	13583	IRFZ34NSTRPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET D2-PAK Udss=60V; Id=30A; Pdmax=88W; Rds=0,05 Ohm	(-55...+175)°C	0,8983	0,7949	по запросу	
72	11441	IRFZ44EPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET TO220AB Udss=60V; Id=48A; Pdmax=110W; Rds=0,023 Ohm	(-55...+175)°C	0,9266	0,8200	по запросу	
73	11789	IRFZ44NLPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET TO262 Udss=55V; Id=49A; Pdmax=110W; Rds=0,022 Ohm	(-55...+175)°C	1,0506	0,9297	по запросу	
74	73 41	IRFZ44NPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET TO220AB Udss=55V; Id=49A; Pdmax=110W; Rds=0,022 Ohm	(-55...+175)°C	0,7096	0,6279	по запросу	
75	18475	IRFZ44NSPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET D2PAK Udss=55V; Id=49A; Pdmax=110W; Rds=0,022 Ohm	(-55...+175)°C	0,7092	0,6276	по запросу	
76	73 42	IRL2505 -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET logik TO220AB Udss=55V; Id=104A; Pdmax=200W; Rds=0,008 Ohm	(-55...+175)°C	1,4660	1,2973	по запросу	
77	9384	IRL3705NPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET TO220AB Udss=55V; Id=77A; Pdmax=130W; Rds=0,01 Ohm	(-55...+175)°C	1,6899	1,4954	по запросу	
78	22205	IRL3705NSPBF -IR	Транз. Пол. 5M N-MOSFET D2PAK Udss=55V; Id=89A; Pdmax=130W; Rds=0,01 Ohm	(-55...+175)°C	1,6896	1,4952	по запросу	
79	24972	IRL540NPBF -Infineon	Транз. Пол. 5M N-MOSFET TO220AB Udss=100V; Id=36A; Pdmax=140W; Rds=0,044 Ohm Logic Level Gate	(-55...+175)°C	0,8000	0,7000	по запросу	
80	16742	IRLR2703 - IR	Транз. Пол. 5M N-HEXFET DPAK Udss=30V; Id=23A; Pdmax=45W; Rds=0,045Ohm	(-55...+175)°C	1,1367	1,0059	по запросу	
81	25131	IRLR2705PBF -IR	Транзистор DPAK MOSFET N-канал, 55B, 28A	-20...+55	0,4400	0,3500	по запросу	
82	21528	IRLR3410PBF - IR	MOSFET, N, 100V, 15A, D-PAK	-20...+55	0,5500	0,4800	по запросу	
83	24231	IXFN520N075T2 - IXYS	MOSFET N-CH 75V 480A SOT227	-20...+55			по запросу	
84	23107	MTH15N20 -Motorola	MOSFET силовой транзистор, TO-3P or TO247; 15A, 200V	-20...+55	2,5500	2,4200	по запросу	
85	25104	SQ4946AEY-T1-GE3 -Vishay Siliconix	Транз. Пол. MOSFET 2N-CH 60V 7A 8SOIC	(-55...+175)°C	3,0000	2,7000	по запросу	
86	23734	STP4NK60ZFP - STM	MOSFET силовой транзистор, N-канал; TO-220FP; 600 V; 4 A; 2 Ohm	(-55...+150)°C	0,6000	0,5400	по запросу	
87	18005	STP9NK50ZFP -STM	Транз. Пол. N-CHANNEL 500V 0.72 OHM TO-220FP ZENER-PROTECTED SUPERMESH POWER MOSFET	-20...+55	0,9252	0,8187	по запросу	
88	23106	TSA20N50M -Truesemi	MOSFET силовой транзистор, TO-3P or TO247; 20.0A, 500V, RDS(on) = 0.26Ohm@VGS = 10 V	-20...+55	2,0500	1,8800	по запросу	
89	5929	2N7002 -Philips	Транз. Пол. MM N-FET ПТ SOT23 Vds=60V, Id=0.18A, Rds=50hm, Vgs=3V, P=0.25W, smd.	(-55...+150)°C	0,0336	0,0297	по запросу	
90	19458	2N7002BK,215 - NXP	Транз. Пол. MM N-FET ПТ SOT23 Vds=60V, 350 mA	-20...+55	0,0550	0,0455	по запросу	
91	20339	BF1005E6327 -Infineon	Транз. Пол. MM RF (up to 1 GHz) N-MOSFET SOT143 Udss=8V; Id=0,025A; Pdmax=0,2W; двухзатворный, Gr=19 dB	(-55...+150)°C	0,2420	0,2200	по запросу	
92	74 22	BF511 -Philips	Транз. Пол. MM N-FET SOT23 Udss=20V; Id=0,03A; Pdmax=0,25W; Yfsmin=4mS	(-55...+150)°C	0,4939	0,4370	по запросу	
93	74 20	BF991 -Philips	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT143 Udss=20V; Id=0,02A; Pdmax=0,2W; Yfsmin=14mS; двухзатворный Idss=(4...25)mA	(-55...+150)°C	0,5950	0,5265	по запросу	
94	74 12	BF998 -NXP	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT143 Udss=12V; Id=0,03A; Pdmax=0,2W; Yfsmin=24mS; двухзатворный Idss=(2...18)mA	(-55...+150)°C	0,3265	0,2889	по запросу	
95	5750	BF998E6327 -Infineon	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT143 Udss=12V; Id=0,03A; Pdmax=0,2W; Yfsmin=24mS; двухзатворный Idss=(2...18)mA	(-55...+150)°C	0,2000	0,1800	по запросу	
96	7405	BF998WR -Philips	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT343R Udss=12V; Id=0,03A; Pdmax=0,3W; Yfsmin=24mS; двухзатворный Idss=(2...18)mA	(-65...+150)°C	0,3004	0,2658	по запросу	
97	18849	BSH103 - Philips	Транзистор SOT23 N-channel	-20...+55	0,1246	0,1102	по запросу	

				<a href="http://www.store.aly.ru">On-line магазин: www.store.aly.ru</a>		Цена за 1 шт. в USD		
36	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт	
98	18109	BSN274 -Philips	Транз. Пол. MM D-MOS TO92 Udss=270 V; Id=0,25 A; Pdm=1W; Rds=8 Ohm	(-55...+150)°C	0,5400	0,4900	по запросу	
99	5659	BSS138LT1G -ONS	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT23 Udss=50V; Id=0,2A; Pdm=0,225W; Rds=3,5 Ohm	(-55...+150)°C	0,0550	0,0450	по запросу	
100	22435	BSS138N - INFINEON	N CHANNEL MOSFET, 230MA, 60V, SOT23	-20...+55			по запросу	
101	17656	BSS84LT1G -ONS	MOSFET, P, 50V, SOT-23	-20...+55	0,1200	0,1000	по запросу	
102	6322	BST72A -Philips	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT54(TO92) Udss=100V; Id=0,19A; Pdm=0,83W; Rds=10 Ohm	(-55...+150)°C	0,1517	0,1342	по запросу	
103	19159	FDS9435A - FAIR	MOSFET силовой транзистор	-20...+55			по запросу	
104	74 31	IRF7103TR -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET logik SO8 Udss=50V; Id=3A; Pdm=2W; Rds=0,13 Ohm	(-55...+150)°C	0,6264	0,5544	по запросу	
105	74 4	IRF7104 -IR	Транз. Пол. MM 2P-HEXFET logik SO8 Udss=-20V; Id=-2,3A; Pdm=2W; Rds=0,25 Ohm	(-55...+150)°C	0,6021	0,5328	по запросу	
106	74 5	IRF7105PBF -IR	Транз. Пол. MM N&P-HEXFET logik SO8 Udss=(25; -25)V; Id=(3,5; -2,3)A; Pdm=2W; Rds=(0,1; 0,25) Ohm	(-55...+150)°C	0,5106	0,4518	по запросу	
107	74 10	IRF7204PBF -IR	Транз. Пол. MM P-HEXFET logik SO8 Udss=-20V; Id=-5,3A; Pdm=2,5W; Rds=0,06 Ohm	(-55...+150)°C	0,4014	0,3552	по запросу	
108	17871	IRF7240TRPBF - IR	Транз. Пол. MM P-Channel SOIC8 Udss=40V Id=10,5A P=2.5W Rds=15mOhm	-20...+55			по запросу	
109	16641	IRF7301PBF -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET SO8 Udss=20V Id=5,2A P=2W Rds=0,05Ohm	(-55...+150)°C	0,8033	0,7108	по запросу	
110	74 6	IRF7303PBF -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET logik SO8 Udss=30V; Id=4,9A; Pdm=2W; Rds=0,05 Ohm	(-55...+150)°C	0,8033	0,7108	по запросу	
111	74 7	IRF7306 -IR	Транз. Пол. MM 2P-HEXFET logik SO8 Udss=-30V; Id=-3,6A; Pdm=2W; Rds=0,1 Ohm	(-55...+150)°C	0,5712	0,5054	по запросу	
112	8058	IRF7307 -IR	Транз. Пол. MM 1N-1P-HEXFET logik SO8 Udss=+-20V; Id=4,3A; Id=-3.6A Pdm=1,4W; Rds=0,05 Ohm	(-55...+150)°C	0,7351	0,6505	по запросу	
113	10308	IRF7309PBF -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET logik SO8 Udss=-30V; Id=-3,6A; Pdm=2,0W; Rds=0,10 Ohm	(-55...+150)°C	0,5378	0,4759	по запросу	
114	5938	IRF7311 -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET logik SO8 Udss=20V; Id=6,6A; Pdm=2W; Rds=0,05 Ohm	(-55...+150)°C	0,6768	0,5989	по запросу	
115	74 14	IRF7314 -IR	Транз. Пол. MM 2P-HEXFET logik SO8 Udss=-20V; Id=-5,3A; Pdm=2W; Rds=0,058 Ohm	(-55...+150)°C	0,7854	0,6950	по запросу	
116	74 30	IRF7314TR -IR	Транз. Пол. MM 2P-HEXFET logik SO8 Udss=-20V; Id=-5,3A; Pdm=2W; Rds=0,058 Ohm	(-55...+150)°C	0,6499	0,5751	по запросу	
117	6560	IRF7316 -IR	Транз. Пол. MM 2P-HEXFET logik SO8 Udss=-30V; Id=-4,9A; Pdm=2W; Rds=0,058 Ohm	(-55...+150)°C	0,9400	0,8260	по запросу	
118	10241	IRF7317 -IR	Транз. Пол. MM 1N-1P-HEXFET logik SO8 Udss=+-20V; Id=6,6A; Id=-5,3A Pdm=2,0W; Rds=0,029 Ohm	(-55...+150)°C	1,2120	1,0725	по запросу	
119	5937	IRF7324PBF -IR	Транз. Пол. MM P-HEXFET SO8 Udss=-20V; Id=-9A; Pdm=2W; Rds=0,018 Ohm	(-55...+150)°C	1,2700	1,1000	по запросу	
120	11755	IRF7331PBF -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET SO8 Udss=20V; Id=7A; Pdm=2W; Rds=0,030 Ohm	(-55...+150)°C	0,6708	0,5936	по запросу	
121	8846	IRF7341PBF -IR	Транз. Пол. MM 2 N-Channel (Dual) MOSFET SOIC8 Udss=55V; Id=4,7A; Pdm=2W; Rds=50 mOhm @ 4.7A, 10V	(-55...+150)°C	0,5600	0,4800	по запросу	
122	17043	IRF7342PBF -IR	Транз. Пол. MM 2P-Channel SO8 -55V -3,4A 2W 105mOhm	-20...+55	0,8234	0,7286	по запросу	
123	74 28	IRF7343PBF -IR	Транз. Пол. MM N&P-HEXFET logik SO8 Udss=(55; -55)V; Id=(+4,7; -3,4)A; Pdm=2W; Rds=(0,05; 0,105) Ohm	(-55...+150)°C	0,6646	0,5881	по запросу	
124	17044	IRF7389PBF -IR	Транз. Пол. MM 1N/1P-Channel SO8 30V 7,3/-5,3A 2,5W 29/58mOhm	-20...+55	0,8014	0,7092	по запросу	
125	11829	IRF7416 - IR	Транз. Пол. MM P-HEXFET SO8 Udss=-30V; Id=-10A; Pdm=2,5W; Rds=0,02Ohm	(-55...+150)°C	0,7442	0,6585	по запросу	
126	74 27	IRF7421D1 -IR	Транз. Пол. MM N-FETKY (с диодом Шоттки) SO8 Udss=30V; Id=5,8A; Pdm=2W; Rds=0,035 Ohm; Ufm=0,5V(I=1A)	(-55...+150)°C	0,5908	0,5228	по запросу	
127	18359	IRF7473PBF -IR	Транз. Пол. MM N-Channel SO8 Udss=100V Id=6.9A P=2.5W Rds=0.026Ohm	(-55...+150)°C	0,9761	0,8272	по запросу	
128	74 16	IRF7501TR -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET logik MICRO8 Udss=20V; Id=2,4A; Pdm=1,25W; Rds=0,135 Ohm	(-55...+150)°C	0,4727	0,4183	по запросу	
129	15723	IRF7503TR -IR	Транз. Пол. MM 2N-HEXFET logik MICRO8	(-55...+150)°C	0,6223	0,5507	по запросу	
130	74 8	IRF7507TR -IR	Транз. Пол. MM N&P-HEXFET logik MICRO8 Udss=(20; -20)V; Id=(2,4; -1,7)A; Pdm=1,25W; Rds=(0,135; 0,27) Ohm	(-55...+150)°C	0,8907	0,7882	по запросу	

		On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a>			Цена за 1 шт. в USD		
36	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт
131	7275	IRF7509TR -IR	Транз. Пол. MM N&P-HEXFET logik MICRO8 Udss=(30; -30)V; Id=(2,4; -1,7)A; Pdmax=1,25W; Rds=(0,135; 0,27) Ohm	(-55...+150)°C	0,4137	0,3661	по запросу
132	18634	IRF7705 - IR	Транз. Пол. MM P-Channel TSSOP-8 Udss=-30V Id=-8A P=1.5W Rds=4mOhm	(-55...+150)°C			по запросу
133	17872	IRF7832 - IR	Транз. Пол. MM N-Channel SO8 Udss=30V Id=20A P=2.5W Rds=4mOhm	(-55...+155)°C			по запросу
134	17807	IRF8313PBF -IR	Транз. Пол. MM N-Channel SO8 Udss=30V Idm=81A Pd=2.0W	(-55...+175)°C			по запросу
135	11692	IRFL014NPBF -IR	Транз. Пол. MM 60V 2,7A N-Channel HEXFET SOT223 No Pb	(-55...+150)°C	0,8000	0,6600	по запросу
136	11051	IRFL9014PBF - IR	Транзистор SOT-223 -60V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET	-20...+55			по запросу
137	17384	IRLD024PBF -Vishay	Транз. Пол. MM N-HEXFET HD1 Udss=60V; Id=-2,5A; Pdmax=1,3W; Rds=0,10 Ohm	(-55...+150)°C	0,7200	0,6200	по запросу
138	74 11	IRLL014N -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET logik SOT223 Udss=55V; Id=2A; Pdmax=2,1W; Rds=0,14 Ohm	(-55...+150)°C	0,4566	0,4040	по запросу
139	74 32	IRLL014NTR -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET logik SOT223 Udss=55V; Id=2A; Pdmax=2,1W; Rds=0,14 Ohm	(-55...+150)°C	0,3334	0,2950	по запросу
140	20963	IRLML0030TRPBF -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET SOT23 Udss=30V; Id=5,2A; Rds=0,028 Ohm	(-55...+150)°C	0,1634	0,1446	по запросу
141	20964	IRLML0060TRPBF -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET SOT23 Udss=60V; Id=2,7A; Rds=0,092 Ohm	(-55...+150)°C	0,1634	0,1446	по запросу
142	5591	IRLML2402TR -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET SOT23 Udss=20V; Id=1,2A; Pdmax=0,54W; Rds=0,25 Ohm	(-55...+150)°C	0,1634	0,1446	по запросу
143	6879	IRLML2502TR -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET SOT23 Udss=20V; Id=4,2A; Pdmax=1,25W; Rds=0,045 Ohm	(-55...+150)°C	0,2266	0,2005	по запросу
144	10400	IRLML2803TRPBF -IR	Транз. Пол. MM N-HEXFET Micro3TM Udss=30V; Id=1,2A; Pdmax=0,54W; Rds=0,25 Ohm	-	0,1578	0,1396	по запросу
145	74 15	IRLML5103TR -IR	Транз. Пол. MM P-HEXFET SOT23 Udss=-30V; Id=-0,76A; Pdmax=0,54W; Rds=0,6 Ohm	(-55...+150)°C	0,2685	0,2376	по запросу
146	74 9	IRLML6302TR -IR	Транз. Пол. MM P-HEXFET SOT23 Udss=-20V; Id=-0,78A; Pdmax=0,54W; Rds=0,6 Ohm	(-55...+150)°C	0,1524	0,1291	по запросу
147	20086	IRLML6344TRPBF -IR	Транз. Пол. MM N-MOSFET SOT23 Udss=30V; Id=5 A; Pdmax=1,3W; Rds=0,029 Ohm	(-55...+150)°C	0,1400	0,1200	по запросу
148	9803	IRLML6402TRPBF -IR	Транз. Пол. MM P-HEXFET SOT23 Udss=-20V; Id=-3,5A; Pdmax=1,1W; Rds=0,06 Ohm	(-55...+150)°C	0,2360	0,2140	по запросу
149	6802	MMBF4392LT1 -ONS	Транз. Пол. MM N-Channel JFET SOT23(TO236AB) Udss=30V; Id=0,05A; Pdmax=0,225W	(-55...+150)°C	0,1089	0,0963	по запросу
150	13349	PMBFJ310 -Philips	Транз. Пол. MM N-FET Low noise SOT23 Udss=25V; Idssmax=0,06A; Pdmax=0,25W; Yfsmin=10mS	(-55...+150)°C	0,1823	0,1613	по запросу
151	23595	RSQ035P03TR -ROHM	MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT6	-20...+55	1,5000	1,3500	по запросу
152	9884	STP9NB50 - STM		-20...+55			по запросу